

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ПЕРЕХОД МЕТАЛЛ—ДИЭЛЕКТРИК И МАГНИТНЫЙ ПОРЯДОК В СИСТЕМЕ $\text{Fe}_x\text{Mn}_{1-x}\text{S}$

Г. В. Лосева, Л. И. Рябинкина, С. Г. Овчинников

Переход металл—диэлектрик (ПМД) в халькогенидных системах магнитных полупроводников коррелирует с изменением магнитных свойств, что связано с особенностями зонной структуры этого класса магнитоупорядоченных соединений [1]. Так, в системе $\text{Cr}_x\text{Mn}_{1-x}\text{S}$, созданной на основе $\alpha\text{-MnS}$, возрастание концентрации хрома приводит для $x_c \approx 0.67$ к возникновению концентрационного перехода металл—диэлектрик, сопровождающегося сменой типа антиферромагнитного упорядочения от II к I [2].

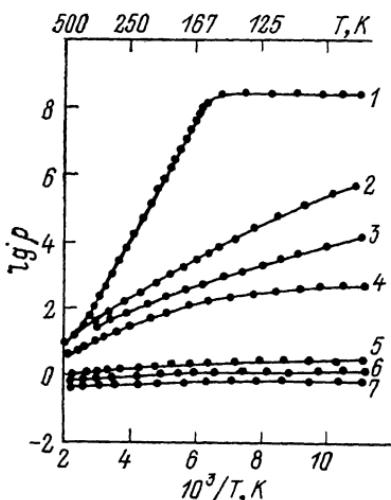


Рис. 1. Температурные зависимости удельного электросопротивления системы $\text{Fe}_x\text{Mn}_{1-x}\text{S}$ для $x=0.00$ (1), 0.3 (2), 0.33 (3), 0.36 (4), 0.4 (5), 0.5 (6), 0.6 (7).

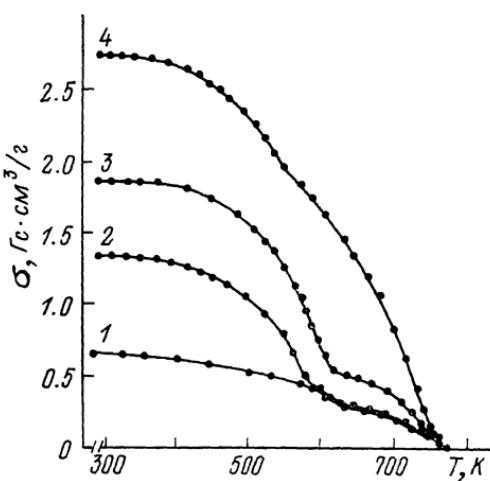


Рис. 2. Температурные зависимости намагниченности $\text{Fe}_x\text{Mn}_{1-x}\text{S}$ в поле $H=0.7$ кЭ для $x=0.3$ (1), 0.4 (2), 0.5 (3), 0.6 (4).

В настоящей работе проведены исследования электрических и магнитных свойств, а также проанализировано изменение электронной структуры в рамках модельных представлений в системе $\text{Fe}_x\text{Mn}_{1-x}\text{S}$ ($0 < x < 0.7$).

Образцы $\text{Fe}_x\text{Mn}_{1-x}\text{S}$ были получены методом вакуумированных кварцевых ампул из чистых элементов. Рентгеноструктурные исследования, проведенные при 300 К на установке ДРОН-2.0 в монохроматизированном излучении CoK_α , показали, что в системе $\text{Fe}_x\text{Mn}_{1-x}\text{S}$ для $0 < x < 0.7$ формируются твердые растворы с гранецентрированной кубической (ГЦК) решеткой $\alpha\text{-MnS}$.

На рис. 1 представлены температурные зависимости удельного электросопротивления ρ для образцов $\text{Fe}_x\text{Mn}_{1-x}\text{S}$. Температурный ход удельного электросопротивления для составов с $0 < x < 0.4$ имеет экспоненциальный характер, а для $0.4 \leq x \leq 0.6$ типичен для полуметаллов с уменьшением ρ при 77 К примерно на восемь порядков. Концентрация $x_c = 0.4$ для системы является критической, так как при этой концентрации происходит смена типа проводимости от полупроводникового до полуметаллического (ПМД в неупорядоченных системах типа Андерсона [3]).

Измерения магнитных свойств системы $\text{Fe}_x\text{Mn}_{1-x}\text{S}$ включали в себя измерения магнитной восприимчивости, намагниченности, спонтанного

магнитного момента, петель гистерезиса в интервале температур 77–800 К.

Для составов с $0 < x < 0.3$ величина магнитной восприимчивости в поле $H=5$ кЭ характерна для антиферромагнетиков и с возрастанием x увеличивается от $\sim 70 \cdot 10^{-6}$ СГСМ/г ($x=0$) до $\sim 182 \cdot 10^{-6}$ СГСМ/г ($x=0.2$), при этом температура Нееля возрастает от 148 до 210 К. Изменение магнитных свойств имеет место для составов с $x > 0.2$. В интервале концентраций $0.3 \leq x \leq 0.6$ установлено возникновение спонтанной намагниченности, которая во внешнем магнитном поле имеет петлю гистерезиса. Величина намагниченности этих составов с возрастанием температуры от 77 до 300 К уменьшается незначительно, а в области 300–800 К в поле $H=0.7$ кЭ наблюдается резкое уменьшение ее величины с ростом температуры (рис. 2). Температура Кюри для различных x составляет $T_k \approx 750 \pm 800$ К.

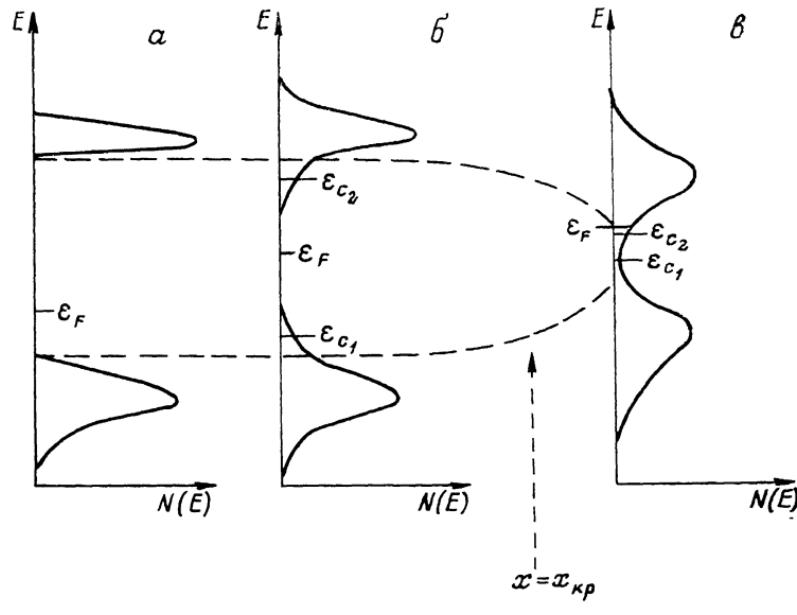


Рис. 3. Схема плотности состояний $\text{Fe}_x\text{Mn}_{1-x}\text{S}$. $x=0$ (a), $x < x_{kp}$ (б), $x > x_c$ (с). Штрихи — уменьшение щели E_g , обусловленное изменением магнитного порядка при $x=x_{kp}$. Здесь ε_{c_1} и ε_{c_2} — пороги подвижности в валентной зоне и зоне проводимости.

Возникновение ферромагнетизма в образцах этих составов подтверждают, кроме того, и ЯГР-спектры [4].

Из полученных результатов следует, что в системе магнитных полупроводников $\text{Fe}_x\text{Mn}_{1-x}\text{S}$ ($0 < x < 0.7$) по мере возрастания x имеет место концентрационный переход металл—диэлектрик при $x_c \approx 0.4$, которому предшествует зарождение магнитного порядка со спонтанным магнитным моментом при $x_{kp} \approx 0.3$.

Делокализация носителей и появление спонтанного момента взаимообусловливают друг друга. С одной стороны, появление носителей в антиферромагнитном полупроводнике приводит к появлению дополнительного косвенного обменного взаимодействия и может вызвать переход в ферромагнитную фазу [5]. С другой стороны, переход от антиферромагнитной структуры, где перескок электронов в узких d -зонах подавлен корреляционными эффектами, к ферромагнитной структуре сопровождается уширением зоны [1]. Подобное уширение происходит, как показано в [2], и при переходах между разными антиферромагнитными фазами, например II тип \rightarrow I тип, лишь бы перескок между соседями с параллельными спинами преобладал бы над перескоком между соседями с антипараллельными спинами. В фазе со спонтанной намагниченностью это

условие выполняется из-за неэквивалентности подрешеток, так что можно ожидать, что с ростом x происходит уширение зон из-за изменения магнитного порядка.

Есть еще один источник уширения зон, обычный для неупорядоченных полупроводников, связанный с появлением хвостов плотности состояний $N(E)$ в запрещенной зоне и постепенным зарастанием псевдощели. Оба этих механизма работают в одну сторону. Модельная схема плотности состояний системы $\text{Fe}_x\text{Mn}_{1-x}\text{S}$ показана на рис. 3. В исходном α - MnS потолок валентной зоны образован гибридными $p-d$ -состояниями, а ближайшая пустая зона — это узкая d -зона. С ростом x появляется псевдощель локализованных состояний с порогами подвижности ε_{c_1} и ε_{c_2} , причем ε_{c_2} движется вниз как вследствие роста беспорядка, так и в результате уширения d -зоны при изменении магнитного порядка. Из-за роста концентрации электронов с возрастанием x уровень Ферми ε_F движется вверх, пересекая ε_{c_2} при $x=x_c$.

Таким образом, описываемый концентрационный переход является переходом типа Андерсона, модифицированным двумя факторами: ростом энергии Ферми и дополнительным опусканием порога подвижности за счет изменения магнитного порядка.

Список литературы

- [1] Нагаев Э. Л. Физика магнитных полупроводников. М.: Наука, 1979. 432 с.
- [2] Лосева Г. В., Рябинкина Л. И., Овчинников С. Г. // ФТТ. 1989. Т. 31. № 3. С. 45—49.
- [3] Мотт Н. Ф. Переходы металл—изолятор. М., 1979. 344 с.
- [4] Лосева Г. В., Рябинкина Л. И., Овчинников С. Г., Баюков О. А. // ФТТ. 1983. Т. 25. № 12. С. 3717—3719.
- [5] Карпенко Б. В., Бердышев А. А. // ФТТ. 1963. Т. 5. № 10. С. 3026—3028.

Институт физики им. Л. В. Киренского
СО АН СССР
Красноярск

Поступило в Редакцию
6 июня 1991 г.

© Физика твердого тела, том 33, № 11, 1991
Solid State Physics, vol. 33, N 11, 1991

ЭЛЕКТРОПОЛЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ В ДИМЕРНЫХ КЛАСТЕРАХ СМЕШАННОЙ ВАЛЕНТНОСТИ

Б. С. Цукерблат, Б. Д. Гейхман

1. Кластеры смешанной валентности (СВ) содержат ионы металла с незаполненными оболочками в различных степенях окисления. Исследование таких систем началось в связи с проблемой магнетизма некоторых окислов [1, 2]. Квантовомеханическая теория показала [3, 4], что спектр пары ионов d^n-d^{n+1} может быть представлен в виде серии обменных мультиплетов, расщепленных туннелированием лишнего электрона (рис. 1).

$$\epsilon_{u(g)}(S) = -J(S(S+1) - S_a(S_a+1) - S_b(S_b+1)) \begin{cases} + & (-1)^{S-1/2} \frac{P(S+\frac{1}{2})}{2S_0+1}, \\ - & \end{cases} \quad (1)$$

где J — многоэлектронный гайзенберговский обменный параметр; S — полный спин кластера $S=S_a+S_b, \dots |S_a-S_b|$; S_a, S_b — спины d^n - и d^{n+1} -ионов (S_0 — меньшее значение из S_a и S_b); P — параметр переноса (двойного обмена); индексы u и (g) относятся к четности делокализованных состояний. В дальнейшем будет рассматриваться антиферромагнитный